

(19)



Europäische Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

Mandant ✓



(11)

EP 0 795 899 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.09.1997 Patentblatt 1997/38

(51) Int. Cl.⁶: H01L 21/331, H01L 29/737

(21) Anmeldenummer: 97103597.7

(22) Anmeldetag: 05.03.1997

IHP 116 & IHP. 125

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

(30) Priorität: 14.03.1996 DE 19609933

(71) Anmelder:
• DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT
70546 Stuttgart (DE)
• TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH
74025 Heilbronn (DE)

(72) Erfinder:

- König, Ulf, Dr.
89075 Ulm (DE)
- Schüppen, Andreas, Dr.
89075 Ulm (DE)
- Dietrich, Harry
74912 Kirchardt (DE)

(74) Vertreter: Fröhling, Werner Otto, Dr. et al
Daimler-Benz AG,
Intellectual Property Management,
Sedanstr. 10/Gebäude 17
89077 Ulm (DE)

(54) Verfahren zur Herstellung eines Heterobipolartransistors

(57) Die Erfindung betrifft die Herstellung von HBT mittels differentieller Epitaxie. Durch die Verwendung einer Emittersmaske (8a) und einer Exside-Inside-Spacer Struktur (9,13) wird eine selbstjustierende Herstellung von Emitter- und Basiskontakt durchgeführt. Die Emitterkontaktschicht (14) wird aus amorphem Silizium hergestellt. Da der gesamte Verfahrensablauf sehr tem-

peraturstabil ist und bei geringeren Implantationsenergien durchgeführt werden kann als herkömmliche Verfahren, lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren für die Massenproduktion taugliche HBT's hoher Schichtqualität herstellen, mit denen hohe Schwingungsfrequenzen erzielt werden.

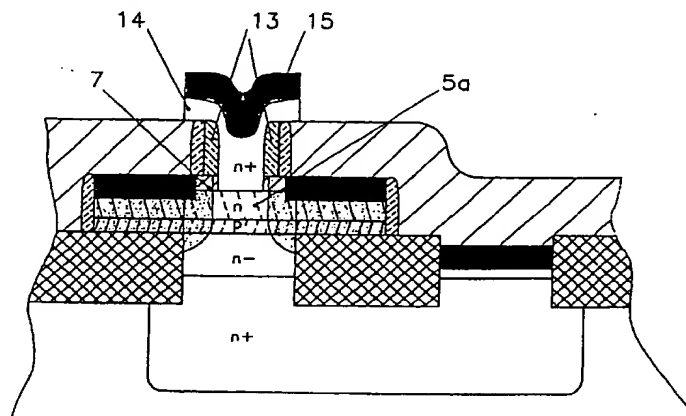


Fig.1e

Entgegenhaltung in IHP. 116,38

EP 0 795 899 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Heterobipolartransistors (HBT) nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Das erfindungsgemäße Verfahren findet insbesondere Verwendung bei der Herstellung von SiGe-HBT. Derzeit sind zwei verschiedene Schichtstrukturen von SiGe-HBTs bekannt. Ein HBT mit niedrig dotiertem Si-Emitter und höher dotierter SiGe-Basis mit abrupten rasterförmigem Ge- und Dotierstoffprofilen und ein HBT mit einer Schichtstruktur mit gradierten Ge- und Dotierstoffprofilen wie in Standardbipolartransistoren. Bei letztgenanntem Schichtaufbau können jedoch die Vorteile der Heterostruktur nicht voll genutzt werden, da der Basisschichtwiderstand wie beim Standardbipolartransistor mit der Dicke der Basis skaliert und nicht wie bei dem SiGe-HBT mit kastenförmigem Ge- und Dotierstoffprofilen fast unabhängig von der Basisdicke ist. Dies schlägt sich vor allem in den maximalen Schwingfrequenzen nieder, die bei der erstgenannten Variante weitaus höher liegen als bei der zweiten Variante.

Nachteilig bei dem SiGe-HBT mit kastenförmigen Ge- und Dotierstoffprofilen ist jedoch, daß aufgrund der steilen Ge- und Dotierstoffprofile die Struktur sehr sensibel auf Temperungen, Implantationen und thermische Oxidationen reagiert und deshalb eine Doppelmesastruktur am vorteilhaftesten ist. Die Mesastruktur des Emitters hat jedoch den Nachteil, daß der Abstand zwischen den die Leitbasis mitbildende Silizid und dem Leitbasis/Emitter-Übergang durch einen Doppelspacer definiert werden muß. Bei dieser Doppelspacertechnologie sind hohe Implantationsenergien notwendig, die zu Defekten in der Basis führen und somit die Schichtqualität und die Transistoreigenschaften nachteilig beeinflussen.

Darüberhinaus war es bisher nicht möglich, einen Poly-Si-Emitter auf einem HBT mit kastenförmigen Ge- und Dotierstoffprofilen zu realisieren, da dann eine Ausdiffusion des Dotierstoffs (z.B. Bor) aus der Basis in Gang gesetzt wird.

Aus einer Veröffentlichung von J.N. Burghartz et. al. in IEEE, 1993, Bipolar Circuits and Technology Meeting, S. 55-62, ist die Herstellung eines Heterobipolartransistors mit selbstjustierend hergestellter SiGe-Basis bekannt. Die SiGe-Basis ist hoch dotiert und der Emitter ist gering dotiert und die Schichten werden mit CVD hergestellt. Als Emitterkontakmaterial wird amorphes Silizium verwendet, das ganzflächig abgeschieden wird (FIG. 1d) und anschließend planarisiert wird. Zur Definition des Emitters wird ein Inside-Spacer verwendet, der plan zu SiO₂ Öffnungen geschliffen wird. Dadurch ergibt sich eine relativ geringe Kontaktfläche, wodurch der Kontaktwiderstand des Emitters erhöht wird. Als Dotiermaterial für den Emitterkontakt wurde As verwendet, wodurch ebenfalls ein relativ hoher Kontaktwiderstand auftritt.

Aufgabe der Erfindung ist deshalb ein Verfahren zur

Herstellung eines Heterobipolartransistors, das für eine Massenproduktion geeignet ist und mit dem produkttaugliche HBTs mit guten Schichtqualitäten und geringen Kontaktwiderständen herstellbar sind.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung hat den Vorteil, daß durch einen Exside-Inside-Spacer-Prozeß mit einem amorphen Si-Emitter die oben aufgeführten Nachteile beseitigt werden. Es können in vorteilhafterweise Standardlithographieverfahren zur selbstjustierenden Herstellung von Emitterbreiten bis zu ca. 0,3 µm eingesetzt werden. Weiterhin entfällt die Si-Mesaätzung des Emitters, dadurch findet die Passivierung des Bauelements an einer sauberen Oberfläche statt. Da bei dem vorliegenden Verfahren weitaus geringere Implantationsenergien als bei der Doppelspacertechnologie notwendig sind, werden hohe Schichtqualitäten erreicht und die Transistoreigenschaften verbessert.

Durch die Verwendung eines Exside-Inside-Spacers kann der Abstand zwischen Leitbasis/Emitter-Übergang und das die Basiszuleitung mitbildende Silizid genau eingestellt werden und dadurch Kurzschlüsse vermieden werden.

Vorteilhaft ist auch die Verwendung von Phosphor bei der Dotierung des amorphen Si-Emitterkontaktes und die anschließende Kurzzeitemperatur bei Temperaturen von mehr als 900°C, da dadurch die Ausdiffusion von Bor aus der Basis verhindert wird. Außerdem hat Phosphor dotiertes amorphes Silizium einen sehr geringen Widerstand.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben unter Bezugnahme auf schematische Zeichnungen.

In den Fig. 1a bis 1f ist an einem Ausführungsbeispiel der Verfahrensablauf dargestellt. Zur Herstellung des differentiellen HBT wird beispielsweise gemäß FIG. 1a in einem p-dotierten Si-Substrat eine n⁺-dotierte Wanne 2 als Kollektorzuleitungsschicht ausgebildet. Auf das Substrat 1 mit Wanne 2 wird eine erste Schicht, die Kollektorschicht 3 aus z.B. n⁻-dotiertem Si epitaktisch gewachsen. In diese erste Schicht werden z.B. durch photolithographische Strukturierung und lokale Oxidation des Siliziummaterials (LOCOS oder recessed LOCOS) Isolationsgebiete 6 erzeugt, die vorzugsweise bis in das Substrat 1 bzw. Wanne 2 reichen. Außerdem ist es möglich mittels selektiv einfüllender Epitaxie in einer auf einem Substrat 1 mit Wanne 2 hergestellten Struktur aus Isolationsgebieten 6 eine erste Schicht, die Kollektorschicht 3 aus n⁻-dotiertem Si aufzuwachsen. Derartige Verfahren sind z.B. in der DE 44 17 916 angegeben. Auf eine derartige Struktur wird z.B. eine p-dotierte SiGe-Schicht und eine n-dotierte Si-Schicht mit einem differentiellen Epitaxie-Verfahren (MBE oder CVD) abgeschieden (FIG. 1a). Dabei wächst monokristallines Halbleitermaterial in den Bereichen zwischen den Isolationsgebieten 6, die z.B. aus SiO₂ hergestellt

sind, und polykristallines Halbleitermaterial auf dem SiO_2 . Es bilden sich die monokristallinen Bereiche bestehend aus den SiGe- und Si-Schichten 4a, 5a die die Basis-Schicht 4a und die Emitterschicht 5a bilden, und polykristalline SiGe- und Si-Schichten 4b, 5b. Diese Schichtenfolge wird thermisch oxidiert. Anschließend wird eine Doppelschicht 7, 8 aus z.B. SiO_2 und Si_3N_4 aufgebracht (FIG. 1a). Aus der Si_3N_4 -Schicht 8 wird mit einem Lithographieschritt und einer Plasmaätzung eine Emitterschicht 8a hergestellt (FIG. 1b). Durch eine nachfolgende Implantation z.B. mit BF_2 bei 40keV und einer Flächendotierung von $6 \cdot 10^{15} \text{cm}^{-2}$ erfolgt eine Umdotierung der Schichtenfolge, derart, daß lediglich der durch die Maske 8a abgedeckte Teil nicht davon betroffen wird (FIG. 1b). Die Grenzen zwischen poly- und monokristallinem Material sind bei der Umdotierung miteingeschlossen. Anschließend wird eine Kurzzeitemperatur durchgeführt und über geeignete Ätz- und Lithographieverfahren wird die Leitbasis 11 und der Kollektoranschluß C strukturiert (FIG. 1c). Es werden an der Emitterschicht 8a und an den senkrechten Flanken der Leitbasis 11 Spacer 9a, 9b aus z.B. SiO_2 erzeugt (FIG. 1c). Nachfolgend wird eine Metallschicht z.B. Ti abgeschieden und es bildet sich im Bereich der Leitbasis und dem Kollektoranschluß C eine Silizidschicht 10. Durch die Spacer 9a, 9b erfolgt die Silizidbildung selbstjustierend. Der Abstand zwischen Leitbasis/Emitter Übergang und der Silizidschicht wird durch den Spacer 9a definiert. Die Ti-Schicht wird außer im Basis- und Kollektorbereich wieder entfernt.

Anschließend wird eine SiO_2 -Schicht 12 ganzflächig abgeschieden und mittels Politurätzung (chemical mechanical polishing (CMP)) das Emitterschichtfenster wieder geöffnet (FIG. 1d). Durch einen nachfolgenden naßchemischen Ätzprozeß wird die Maske 8a im Fensterbereich entfernt und es wird ein Inside-Spacer 13 aus z.B. poly-Si oder einer Kombination aus dünnem Nitrid und poly Si gebildet (FIG. 1e). Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, daß die für die Spacer-Herstellung notwendige Plasmaätzung auf der Oxidschicht 7 stoppt, so daß die Emitterschicht 5a nicht von der Plasmaätzung beeinflusst wird. Der Inside-Spacer definiert die Emitterbreite und es lassen sich Emitterbreiten z.B. von etwa $0,4 \mu\text{m}$ realisieren.

Die Oxidschicht 7 im Emitterbereich wird anschließend naßchemisch entfernt. Es wird amorphes Si zur Bildung einer Emitterkontaktschicht 14 abgeschieden. Zur Herstellung einer n^+ -dotierten Emitterkontaktschicht 14 wird das amorphe Si mit Phosphor dotiert und nachfolgend ein Kurzzeitausheilschritt durchgeführt. Dieser Kurzzeitausheilschritt findet bei einer Temperatur von mehr als 900°C statt. Der Emitterkontakt wird strukturiert und es kann noch zusätzlich auf der amorphen Si-Schicht selektiv zum SiO_2 eine Silizidschicht 15, z.B. mit Ti, ausgebildet werden (FIG. 1e). Bei einer derartigen Emitterkontaktherstellung treten keinerlei Probleme beim Übergang von der amorphen Si-Kontaktschicht 14 zur monokristallinen n-Emitterschicht 5a auf, da die monokristalline Emitterschicht 5a

nicht einem Plasmaätzprozeß ausgesetzt wird und eine gute Schichtqualität besitzt. Außerdem ist vorteilhaft, daß der aktive Basis/Emitter Übergang nicht durch Ausdiffusion aus dem amorphen Si bestimmt wird, sondern lediglich durch die Dotierungsverhältnisse während des Epitaxieverfahrens.

Da die Temperaturen der Kurzzeitausheilschritte bei mehr als 900°C liegen können, was oberhalb der zulässigen Temperatur für metastabile SiGe-Schichten liegt, ist das erfindungsgemäße Verfahren temperaturstabiler als bekannte Verfahren der Bipolarherstellung.

Es folgt anschließend das Öffnen der Kontaktlöcher für den Basis- und Kollektoranschluß und eine Standardmetallisierung zur Herstellung der Kontakte C, B, E (FIG. 1f).

Die Erfindung ist nicht auf die im Detail beschriebene Herstellung eines npn-HBT beschränkt, sondern auf komplementäre Dotierung und auf gewöhnliche Bipolartransistoren in analoger Weise anwendbar. Das Halbleitermaterial ist nicht auf Si und SiGe beschränkt. Insbesondere können auch III/V-Halbleiterverbindungen zum Einsatz kommen. Es bietet sich auch die Möglichkeit einer "Collector-on-top"-Anordnung, bei welcher die Reihenfolge der Transistorschichten umgekehrt ist.

Ein typischer Aufbau für einen nach der Erfindung hergestellten SiGe-HBT wird im folgenden Zahlenbeispiel angegeben:

- ein p-Si-Substrat 1 mit einem spezifischen Widerstand von $20 \Omega \text{cm}$
- eine Si-Kollektorzone 2 mit einem Schichtwiderstand von $10 \Omega/\text{Flächeneinheit}$
- eine Si-Kollektorschicht 3 mit einer n^- -Dotierkonzentration von $1 \cdot 10^{16}$ bis $5 \cdot 10^{17} \text{cm}^{-3}$ und einer Schichtdicke von 200nm bis 1000nm.
- eine SiGe-Basischicht 4a mit einer p-Dotierkonzentration von $2 \cdot 10^{19} \text{cm}^{-3}$ und einer Schichtdicke von 40nm
- eine Si-Emitterschicht 5a mit einer n-Dotierkonzentration von $2 \cdot 10^{18} \text{cm}^{-3}$ und einer Schichtdicke von 70nm
- einer amorphen Si-Emitterkontaktschicht 14 mit einer Schichtdicke von 150nm und einer Phosphorimplantation von $1 \cdot 10^{16} \text{cm}^{-2}$ bei 20keV
- Exside-Spacer mit einer Breite von 150nm
- Inside-Spacer mit einer Breite von 100nm
- Silizidschichten aus TiSi_2 mit einer Schichtdicke von 50nm
- eine Metallisierung der Kontakte C,B,E mit einer AlTiSi-oder AlSiCu-Schicht mit einer Schichtdicke

von 1 μm .

Desweiteren ist es vorteilhaft zur Herstellung einer Kollektorschicht 3, nach der Inside-Spacerätzung durch die Emittieröffnung ohne weitere Maske eine zusätzliche Dotierung z.B. mit Phosphor mit einer Flächendotierung von $5 \cdot 10^{12} \text{cm}^{-2}$ bei 100keV durchzuführen (selektiver implantierter Kollektor).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Heterobipolartransistors, bei dem auf einer monokristallinen Zuleitungsschicht eine strukturierte erste Schicht mit einer Kollektorzone und mit diese umgebenden Isolationsgebiete erzeugt wird und über der Kollektorzone eine monokristalline Transistor-Schichtenfolge und gleichzeitig über den Isolationsgebieten eine polykristalline Schichtenfolge gewachsen wird, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Emitterschicht der monokristallinen Transistor-Schichtenfolge durch eine geeignete Maske abgedeckt wird und die der Emitterschicht entsprechende polykristalline Schicht als Teil des Basiszuleitung ausgebildet wird, derart, daß die Grenzen zwischen poly- und monokristallinem Material bei der Umdotierung mit eingeschlossen sind,
- daß an den senkrechten Flanken der Maske und der Basiszuleitung äußere Oxid-Spacer ausgebildet werden und anschließend eine selbstjustierende, teilweise Umwandlung des Basiszuleitung in Silizid durchgeführt wird, so daß der Abstand zwischen Leitbasis/Emitter und Silizid durch den Spacer bestimmt wird,
- daß die Maske über dem Emitterbereich entfernt wird und zur Definition des Emitters eine Exside-Inside-Spacer-Struktur gebildet wird, und
- daß hochdotiertes amorphes Halbleitermaterial zur Herstellung des Emitterkontaktes auf die Emitterschicht abgeschieden wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Heterobipolartransistor aus einer Si/SiGe-Heterostruktur mit einer p-dotierten SiGe-Basis und einem gering n-dotierten Si-Emitter gebildet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Transistorschichtenfolge eine Oxid-/Nitrid-Doppelschicht aufgebracht wird und mit einem Lithographie- und Ätzschritt eine zur Definition des Emitters geeignete Nitrid-Maske hergestellt wird, und die Oxidschicht als Schutzschicht erhalten bleibt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

net, daß die Basiszuleitung durch BF_2 -Implantation der polykristallinen Schichtenfolge mit anschließender Kurzzeitemperung und einem nachfolgenden Maskierungsschritt hergestellt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

- daß zum Entfernen der Maske über dem Emitterbereich die gesamte Struktur mit SiO_2 abgedeckt wird und mittels Politurätzung ein Emitterfenster geöffnet wird,
- daß anschließend die Nitrid-Maske naßchemisch entfernt wird, derart das die Ätze an der Oxidschicht stoppt,
- daß durch Abscheidung von poly-Silizium und anschließendes Ätzen an den senkrechten Flanken der Emittieröffnung Inside-Spacer hergestellt werden, und
- daß die die Emitterschicht schützende Oxidschicht naßchemisch entfernt wird und hochdotiertes amorphes Silizium als Emitterkontaktschicht auf die Emitterschicht aufgebracht wird und ein Kurzeitausheilschritt durchgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Emitterkontaktschicht mit Phosphor implantiert wird bei Energien von 20keV und mit einer Flächendotierung von 10^{16}cm^{-2} .

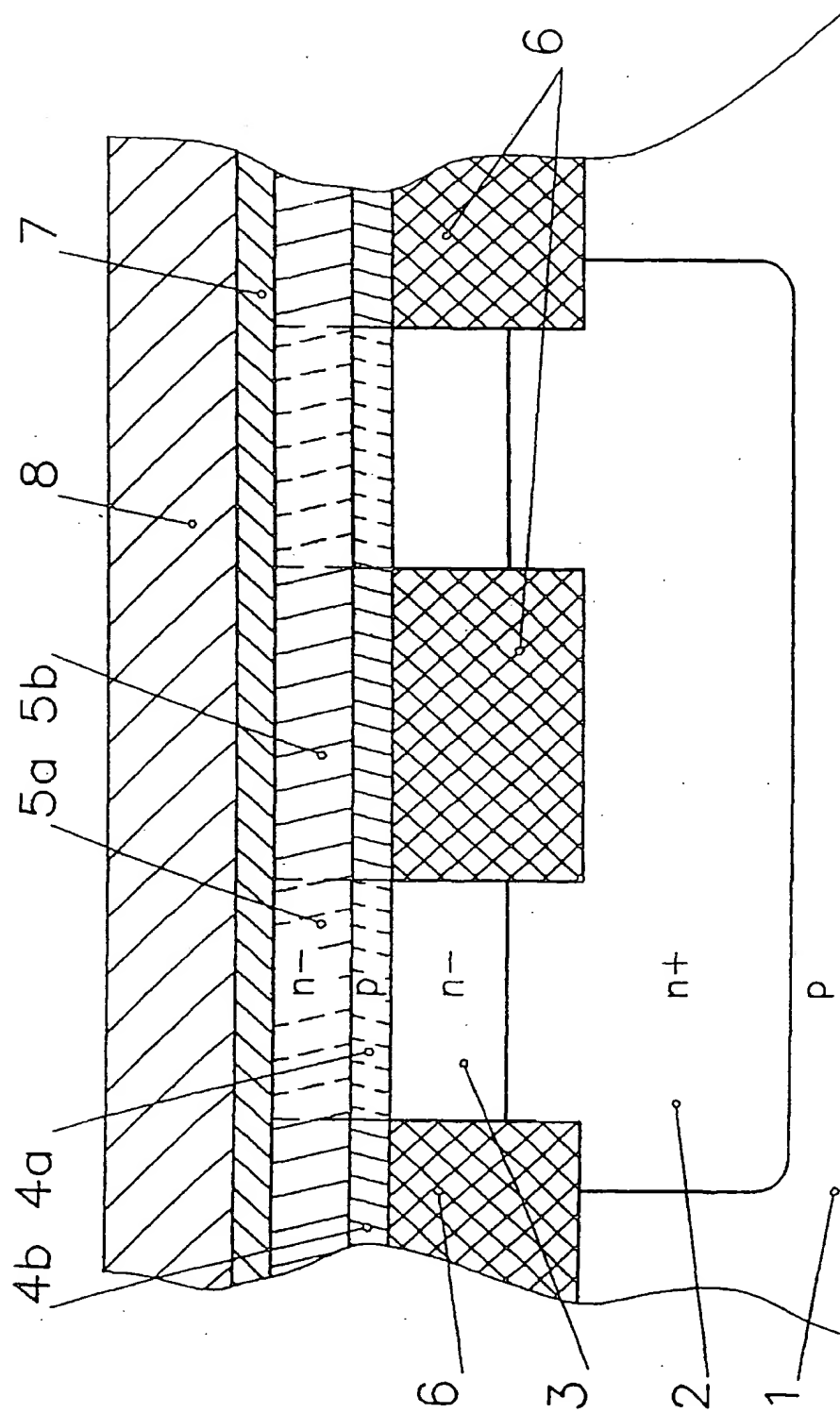
7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kurzeitausheilung bei mehr als 900°C durchgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß durch den Inside-Spacer Emitterbreiten bis zu $0,3 \mu\text{m}$ erreicht werden.

9. Verfahren nach den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,

- daß das amorphe Silizium der Emitterkontaktschicht über die Fensterbreite ausgebildet und dadurch eine größere Kontaktfläche hergestellt wird, und
- daß darauf eine Silizidschicht aufgebracht wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Transistorschichten in umgekehrter Reihenfolge gewachsen werden und der Kollektor- und Emitteranschluß vertauscht angeordnet werden.



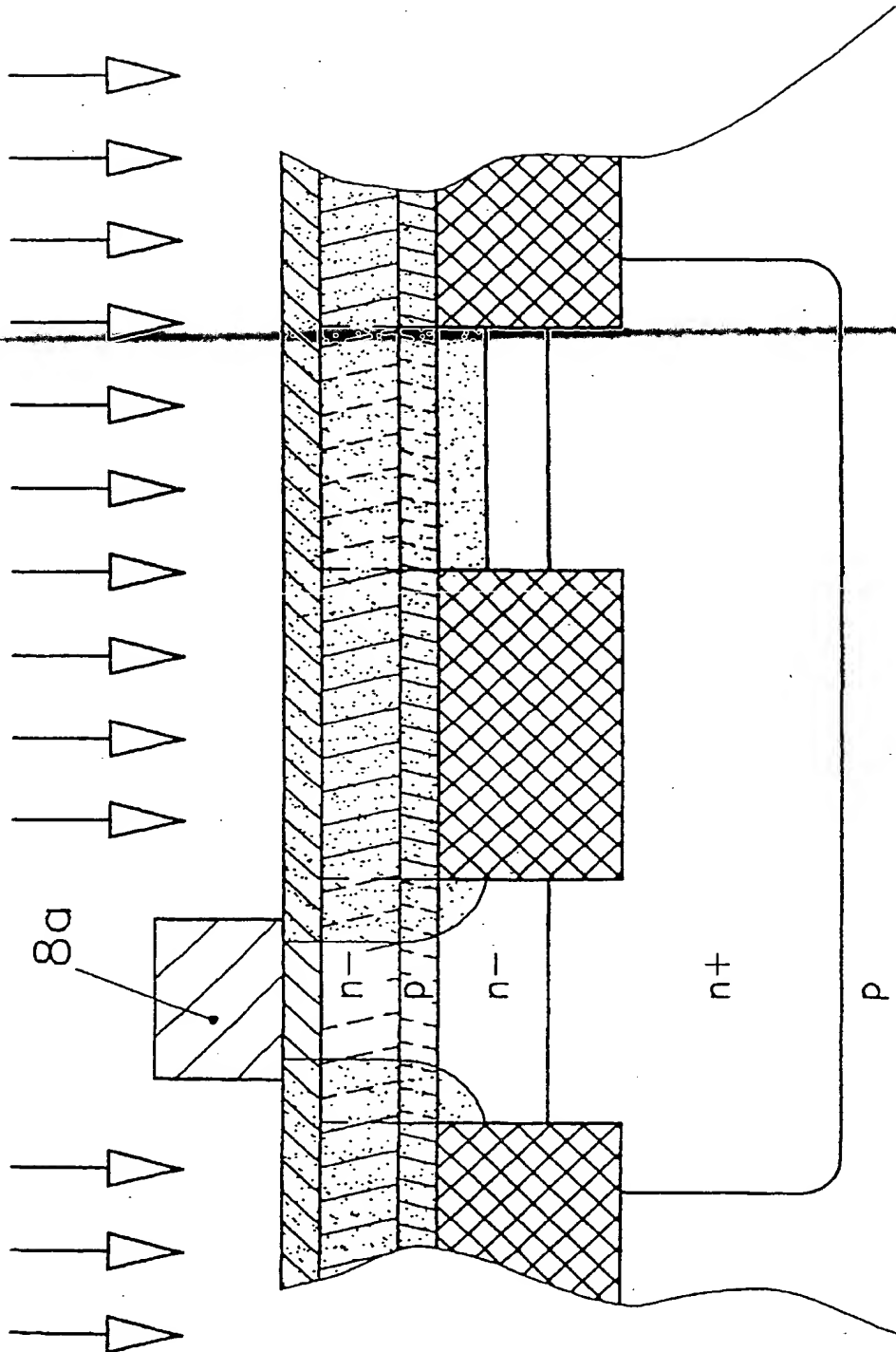


Fig. 1b

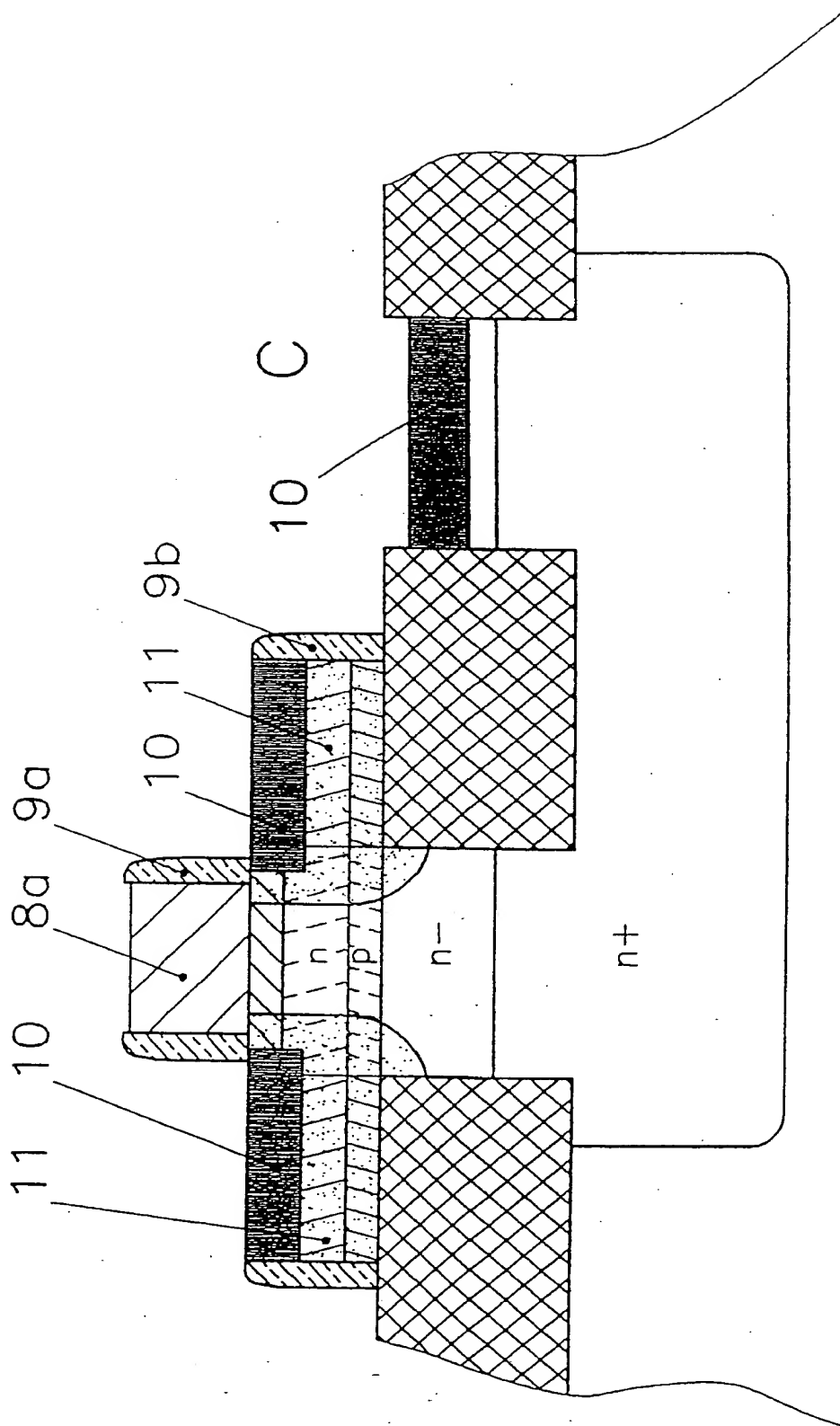
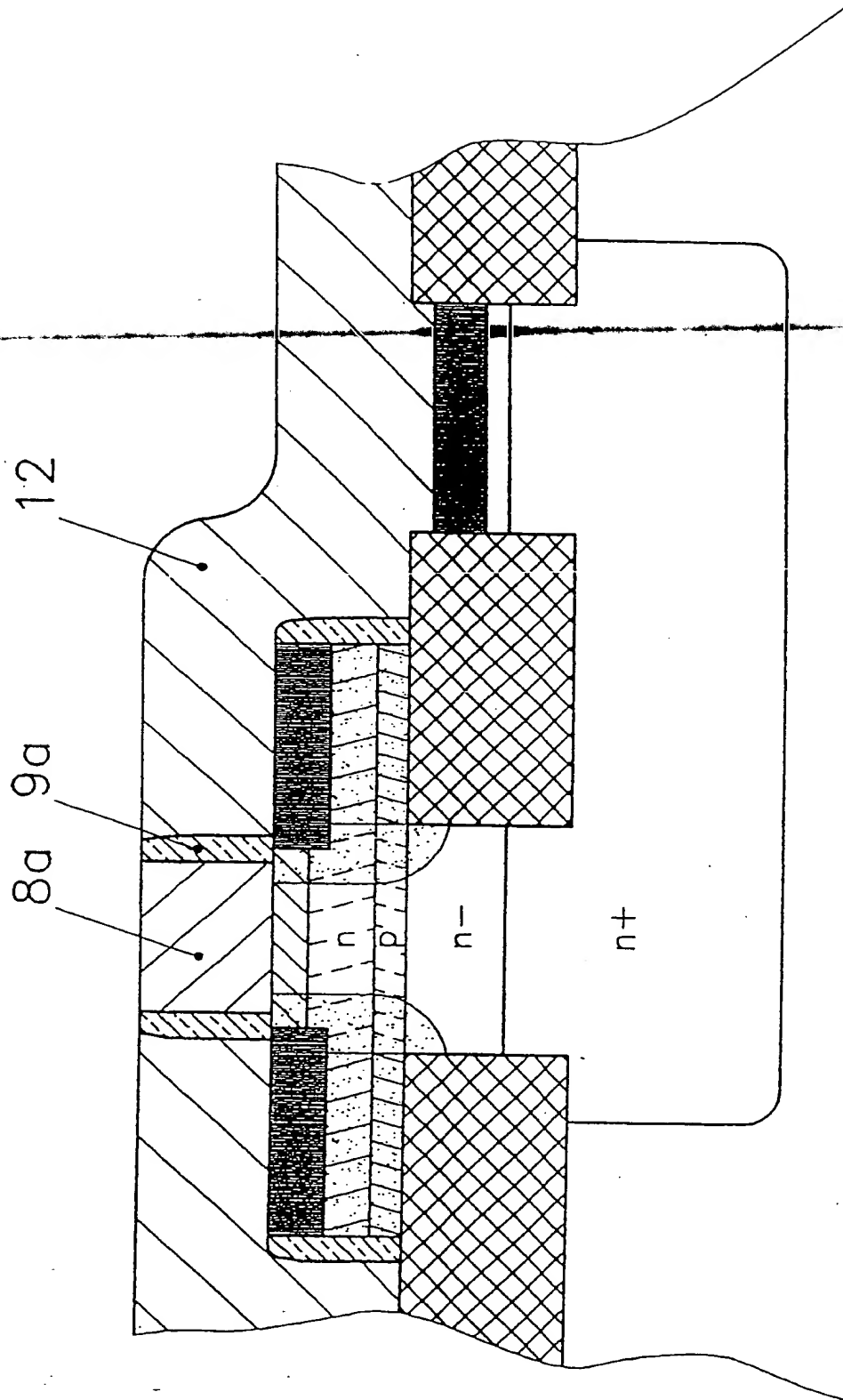


Fig. 1c



1915

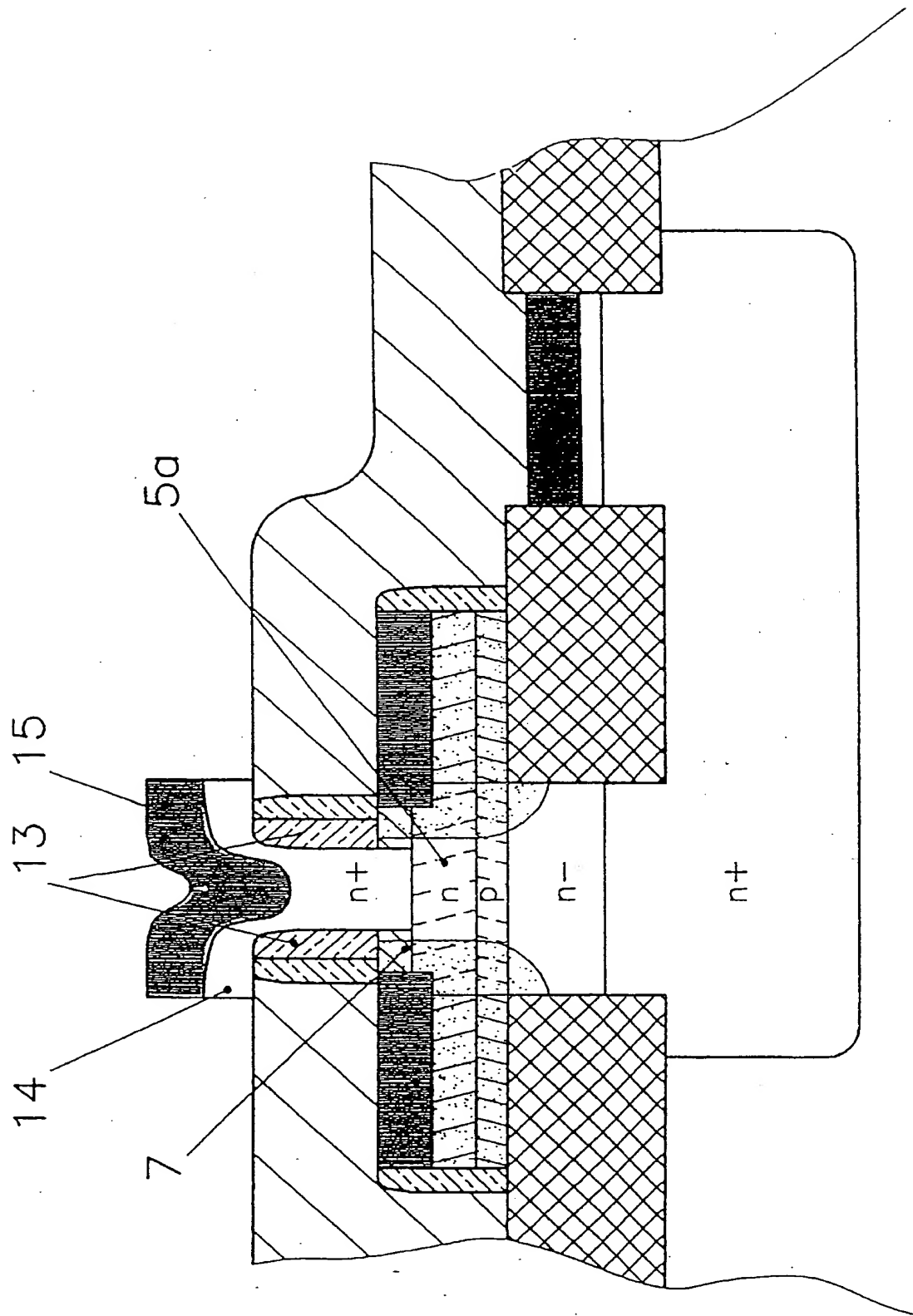


Fig.1e

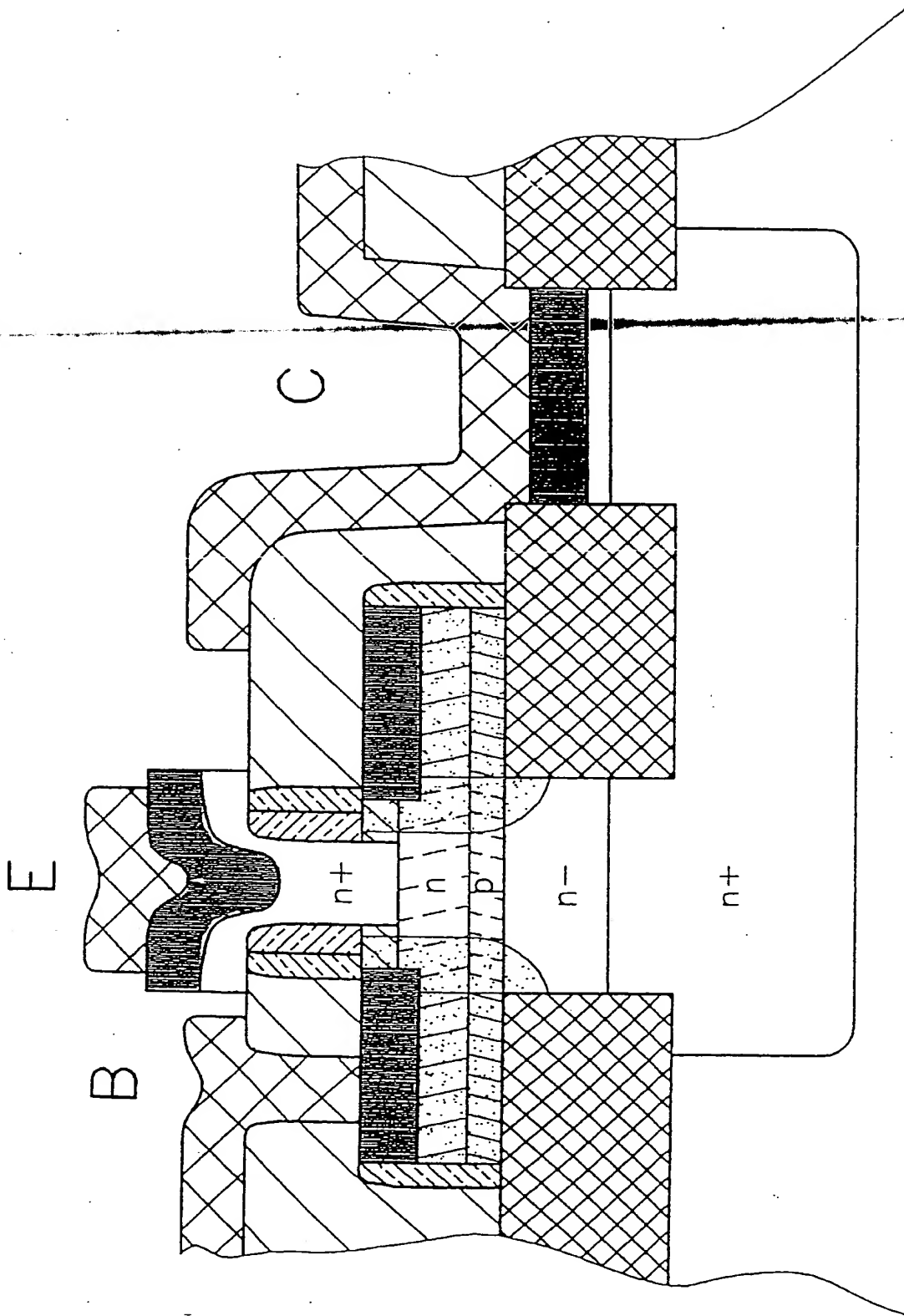


Fig.1f



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 10 3597

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE 41 02 888 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) * das ganze Dokument *	1,2	H01L21/331 H01L29/737
A	EP 0 684 639 A (DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT) * das ganze Dokument *	1,2	
D,A	& DE 44 17 916 A (DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT)		
A	EP 0 550 962 A (AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY) * das ganze Dokument *	1,2,4,5	
A	EP 0 507 454 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) * das ganze Dokument *	1,2	
A	EP 0 551 185 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) * das ganze Dokument *	1,2	
D,A	PROCEEDINGS OF THE BIPOLAR/BICOMS CIRCUITS AND TECHNOLOGY MEETING, MINNEAPOLIS, OCT. 4 - 5, 1993, Nr. -, 1. Januar 1993, JOPKE J, Seiten 55-62, XP000482242 BURGHARTZ J N ET AL: "APCVD-GROWN SELF-ALIGNED SIGE-BASE HBTS" * das ganze Dokument *	1,2	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H01L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 30. Juni 1997	Prüfer Baillet, B
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 03.82 (P04C03)

